



## 超快恢复整流二极管 Ultra-Fast Recovery Rectifier Diodes

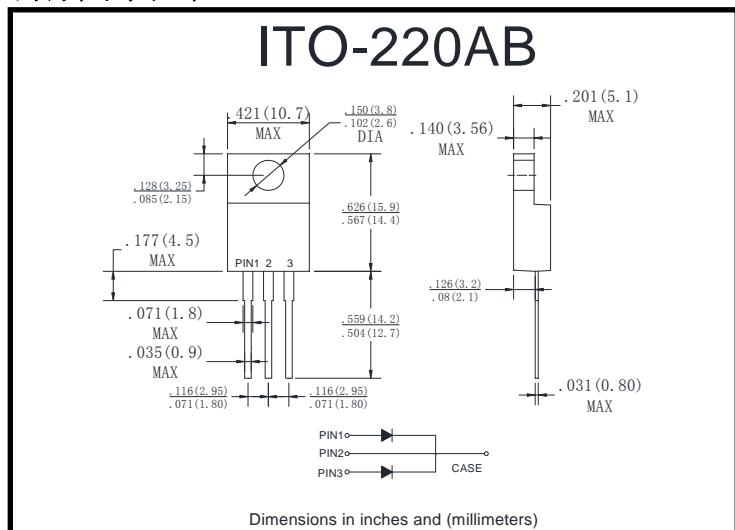
## ■ 特征 Features

- $I_o$  10.0A
- $V_{RRM}$  100V~600V
- 玻璃钝化芯片 Glass passivated chip
- 耐正向浪涌电流能力高  
High surge forward current capability

## ■ 用途 Applications

- 快速整流用  
High speed switching

## ■ 外形尺寸和印记 Outline Dimensions and Mark



## ■ 极限值 (绝对最大额定值)

## Limiting Values (Absolute Maximum Rating)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	MUR-FCT				
				1010	1015	1020	1040	1060
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	V		100	150	200	400	600
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	$I_o$	A	正弦半波 60Hz, 电阻负载, $T_c$ (Fig.1) 60Hz Half-sine wave, Resistance load, $T_c$ (Fig.1)				10	
正向(不重复)浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	$I_{FSM}$	A	60Hz正弦波, 一个周期, $T_a=25^\circ C$ 60Hz sine wave, 1 cycle, $T_a=25^\circ C$				55	
正向浪涌电流的平方对电流浪涌持续时间的积分值 Current Squared Time	$I^2t$	$A^2s$	1ms $\leq t < 8.3ms$ $T_j=25^\circ C$ , 单个二极管 1ms $\leq t < 8.3ms$ $T_j=25^\circ C$ , Rating of per diode				12	
贮存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$	$^\circ C$					-55 ~ +150	
结温 Junction Temperature	$T_j$	$^\circ C$					-55 ~ +150	

■ 电特性 ( $T_a=25^\circ C$  除非另有规定)Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ C$  Unless otherwise specified)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition	MUR-FCT				
				1010	1015	1020	1040	1060
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	V	$I_{FM}=5.0A$		0.975	1.30	1.5	
反向峰值电流 Peak Reverse Current	$I_{RRM1}$	$\mu A$	$V_{RM}=V_{RRM}$	$T_a=25^\circ C$		10		
	$I_{RRM2}$			$T_a=125^\circ C$		500		
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	$Tr$	ns	$I_F=0.5A$ $I_{RM}=1A$ $I_{RR}=0.25A$		35		50	
热阻 Thermal Resistance	$R_{\theta J-C}$	$^\circ C/W$	结和壳之间 Between junction and case		2.0			



## ■特性曲线(典型) Characteristics(Typical)

